(54) MANUFACTURE OF RESIN SEALED TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) 61-219143 (A)

(43) 29.9.1986 (19) JP

(21) Appl. No. 60-59966

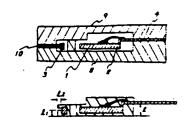
(22) 25.3.1985

(71) NEC CORP (72) TADAYOSHI SAITO

(51) Int. Cl⁴. H01L21/56,H01L23/48

PURPOSE: To secure the creeping distance between a supporting part and a heat dissipation plate as well as to enable to guarantee the dielectric withstand voltage of the title semiconductor device by a method wherein the recessed part provided on a lead frame is supported by the supporting member which is slidably provided in a molding mold, the end part of an outer lead is fixed by a molding mold, and a semiconductor device is formed by performing resin

CONSTITUTION: A supporting part 10, consisting of a silicon film, provided in a molding mold is installed in the recessed part formed on the side face of the metal part on the front part 5 of a lead frame. As a result, a resin insulating part 1 can be formed in uniform thickness, and the heat dissipation property of the bottom part can be maintained. When the distance from the bottom face to the outer lead is set at I, the distance from the bottom face to the aperture part of the led frame is set at l_1 and the distance in lateral direction from the resin end face to the lead frame is set at l_2 , the distance from the bottom face of resin to the lead frame can be made equal to or more than that between the bottom face and the outer lead by adjusting the l_1 and l_2 , especially l_2 .



4: external lead, 8: bottom force. 9: top force

9日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭61 - 219143

Int Cl.

識別記号

"广内整理番号

④公開 昭和61年(1986) 9月29日

21/56 23/48 H 01 L

R-6835-5F 7357-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

9発明の名称 樹脂封止形半導体装置の製造方法

> 昭60-59960 2)特

❷出 昭60(1985)3月25日

登発 明 莪 東京都港区芝5丁目33音1号 日本電気株式会社市

東京都港区芝5丁目33番1号

顋 日本電気株式会社 弁理士 内原 沙代

樹脂製止形半導体整置の製造方法

2 特許請求の範囲

半導体素子を搭載した樹脂對止形半導体装置用 のリードフレームの偶面部に凹状のくぼみを形成 し、成形金型内に推動可能なる如く設置された支 持体により前記リードフレームの凹状のくぼみ部 を支持し、かつリードフレームの進部、才なわち - 外部リードの端部を成形金型にて固定して樹脂封 止成形することを特徴とする樹脂對止形半導体袋 置の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は樹脂封止形半導体装造の製造方法に関

第3図及び第4図に従来の樹脂封止形半導体を 置の平面図及び第3図A-A′線による新面図を 示した。第4図から明らかなように樹脂對止形半 導体袋量の絶縁部1はリードフレーム2の直下に 樹脂が一様な厚みを持たせた構造とし、樹脂によ る絶縁性を図っている。直襲部1として一様な虫 順厚を達成するために、リードフレーム 2 の前部 3 (支持部と略記する)及び外部リード4 全成型 全型で圧壊させる方法を採用している。 第5 図は 従来技術により半導体装置を搭載したリードフレ - 4を成形金型内に設置した断面図である。リー ドフレーム 2 の前部 3 にあたる金属部と一体成形 されているリードフレーム支持体1及び外部リー ド 4 とを上部,下部の両金型8,9にて固定して いるとの状態で樹脂=上すると第2図に示す樹脂 封止形半導体装置が得られる。

〔 発明が解決しよりとする問題点〕

上述した従来の樹脂對止形半導体装置はリード フレーム支持体1と外部リード4の固定にエリリ

BEST AVAILABLE COPY - A TET O CHE O DE LE CORRETTO CE

特開昭61-219143 (2)

ができるが、支持部7は成型後樹脂の外側部で切断された形となっているので、その地部は樹脂外に貫出することになる。従って、放熱複取付時に支持部と放熱板との間で沿面距離が不十分に原因し、絶縁耐圧を確保することが困難であるという欠点があった。

本発明は前配従来技術の欠点を撤去し、支持部 と放熱板との沿面距離を確保し、電子機器模/音時 に要求される絶縁耐圧を保証する荷服耐止形半導 体装置の製造方法を提供することを目的とする。 [問題点を解決するための手段]

本発明の樹間對止形半導体装置の製造方法は、 半導体素子を搭載した樹脂對止形半導体装置用の リードフレームの偏面部に凹状のくぼみ部を形成 し、成形金型内に層動可能なる如く設置された支 持体により前配リードフレームの凹状のくぼみ部 を支持し、かつリードフレームの増部、すなわち 外部リードの増部を成形全型にて固定して樹脂對 止成形することを特徴として構成される。

[発明の効果]

(実施例)

以上説明したように、本発明によれば、外部リート以外の金属製出部に対し沿面距離を十分に確保できる標準を有する樹脂對止形半導体装置の製造が可能となり、電子機器に装着された原に要求される絶縁性を十分に保証し得る樹脂對止形半導体装置の供給が可能となる。

4 図画の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を説明するための成型金型に半導体装置を接着したものの断面図、第2図は本発明の一実施例により製造された樹脂対止半導体装置の断面図、第3図及び第4図はそれぞれ従来の樹脂対止形半導体装置の平面図及び第3図A-A/線による断面図、第5図は従来の半導体装置を搭載したリードフレームを成型金型内に装着したものの断面図である。

1 ……側面絶縁部、2 ……リードフレーム、3 ……リードフレームの前部、4 ……外部リード、 5 ……ペレット、6 ……内部結果、7 ……リード 次に、本発明について図面を参照して説明する。 第1図は本発明の一実施例を説明するための成型 全型の内部所面図である。

第1図に示すよりに、リードフレーム2の前部3にあたる金属部の質面に形成された凹部に対し、成形金型に設置された振動可能なる支持体10を接着する。支持体は排でも板でもよく、また複数個であってもよい。な4外部リード4は従来技術と同様に金型にて支持する。

これにより歯弱による絶縁部1は一様なる厚み が確保でき、底面部からの放熱性が維持できる。

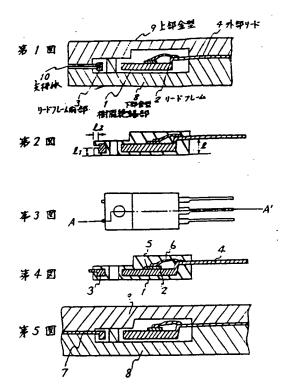
第2図は本発明による製造方法によって、製造された関節対止形半導体装置の所面図である。第 2図にかいてとは底面から外部リードまでの距離。 と、は底面からリードフレームの隣口部までの距離。 と、は、成面距離面からリードフレームまでの検 方向の距離である。すなわちと、とと、特にと、を 加減することにより関節底面からリードフレーム までの距離を底面から外部リードまでの距離と同 等もしくはそれ以上にすることが可能である。

フレーム支持体、8 ……下部金型、9 ……上部金型、10 …… 成形金型に設置した支持体。

代理人 弁理士 内 源

BEST AVAILABLE COPY

特開昭61-219143 (2)



BEST AVAILABLE COPY